

多目的アニール装置

特徴

多目的なアニール処理が可能です。

手動トランスファーロードにより、加熱部への試料の出入れが短時間で行なえ、
高速の昇温／降温が可能です。

仕様

- ガス制御部 窒素、アルゴン、酸素導入
- 加熱部 電気加熱方式（1ゾーン）
基板サイズ：□25mm×1枚
基板加熱温度：Max. 1100℃
- 搬送室 基板導入ハッチ
手動トランスファーロード方式
- 真空排气部 ロータリーポンプ（167L/min）
- 電機制御部 操作パネル
基板加熱電源（プログラマブル温度制御）
各種インターロック・異常処理機能



名城大学殿 納入設備